

КТ336А-КТ336Г

ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ LOW-POWER HIGH-FREQUENCY TRANSISTORS

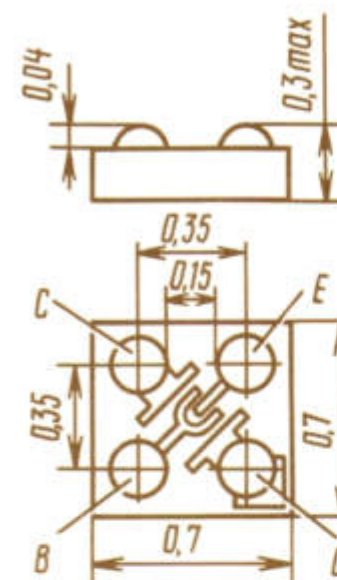
Транзисторы КТ336А-КТ336Г предназначены для работы в аппаратуре широкого применения.

Si-n-p-n-EP

The КТ336А-КТ336Г transistors are designed for use in wide range of applications.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДАННЫЕ $t_{amb} = -60...+85^{\circ}\text{C}$ MAXIMUM RATINGS

$I_{C\text{ max.}}$, mA	20
$U_{CBO\text{ max.}}$, V	10
$U_{CE\text{ max.}}$ ($R_{BE} \leq 3\text{ k}\Omega$), V	10
$U_{EBO\text{ max.}}$, V	4
$P_{C\text{ max.}}$ ($t_{amb} \leq 55^{\circ}\text{C}$), mW	50
$t_j\text{ max.}$, $^{\circ}\text{C}$	105



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	КТ336						Режимы Conditions
	А	Б	В	Г	Д	Е	
I_{CBO} , μA	$\leq 0,5$		$\leq 0,5$		$\leq 0,5$		$U_C = 10\text{ V}$
I_{EBO} , μA	≤ 1		≤ 1		≤ 1		$U_E = 4\text{ V}$
h_{21E}	20–60	40–120	≥ 80	20–60	40–120	≥ 80	$U_C = 1\text{ V}$ $I_C = 10\text{ mA}$
$ h_{21e} $	$\geq 2,5$	$\geq 2,5$	$\geq 2,5$	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	$U_C = 2\text{ V}$ $I_E = 5\text{ mA}$ $f = 10^8\text{ Hz}$
$U_{CE\text{ sat}}$, V	$\leq 0,3$		$\leq 0,3$		$\leq 0,3$		$U_C = 1\text{ V}$
$U_{BE\text{ sat}}$, V	$\leq 0,9$		$\leq 0,9$		$\leq 0,9$		$I_C = 10\text{ mA}$
C_c , pF	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	$U_C = 5\text{ V}$ $f = 10^7\text{ Hz}$

Параметры Parameters	KT336						Режимы Conditions
	А	Б	В	Г	Д	Е	
C_e, pF	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	$U_E = 0$ $f = 10^7 \text{ Hz}$
t_s, ns	≤ 30	≤ 30	≤ 50	≤ 15	≤ 15	≤ 15	$I_C = 10 \text{ mA}$ $I_B = 1 \text{ mA}$

